

**ПРОТОКОЛ № 7/2019**  
Заседания Конкурсной Комиссии  
на замещение вакантных должностей научных работников  
Федерального государственного автономного научного учреждения  
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники  
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук

г. Москва

5 сентября 2019 г.

**Присутствовали:**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Председатель комиссии             | - доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН - С.А.Гамкрелидзе                                       |
| Заместитель председателя комиссии | - кандидат физико-математических наук, доцент заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН - Д.С. Пономарев |
| Секретарь комиссии                | - кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН - Р.А. Хабибуллин                              |
| Члены комиссии:                   | - кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов   |
|                                   | - доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» - Ю.В. Колковский  |
|                                   | - член-корреспондент РАН, директор ФТИАН имени В.К.Валиева РАН - В.Ф. Лукичев                                     |
|                                   | - главный научный сотрудник, профессор кафедры Электроники НИЯУ «МИФИ», доктор технических наук - Д.В.Громов      |

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

**Повестка дня:** Проведение конкурса на замещение вакантной должности ведущего научного сотрудника лаборатории № 102 лаборатории исследования процессов электронной литографии формирования сверхкороткоканальных нм-транзисторов.

**Слушали:**

1. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса, от Лисицкого Антона Павловича для избрания его на должность ведущего научного сотрудника лаборатории исследования процессов электронной литографии формирования сверхкороткоканальных нм-транзисторов. Директор зачитал характеристику Лисицкого А.П., подписанную заместителем директора по научной работе Д.С.Пonomаревым. В ней, в частности отмечается, что Лисицкий А.П. является одним из основных специалистов института в области СВЧ измерений и разработки СВЧ монолитных интегральных схем, принимает деятельное участие в развитии приборной базы института, в создании оригинальных методик СВЧ измерений. Участвовал в качестве соисполнителя в большинстве НИОКР, проводимых в ИСВЧПЭ РАН, является



исполнителем большинства патентных отчетов института, что обусловлено его высокой эрудицией в различных областях СВЧ техники и в патентоведении. Принимает участие в работах по государственному оборонному заказу, выполняемых в ИСВЧПЭ РАН. Под его руководством в лаборатории № 102 разработаны монолитные микросхемы Ka-диапазона с характеристиками мирового уровня.

Имеет более 29 публикаций, получены 5 авторских свидетельств СССР, два патента на изобретение России.

Лисицкий Антон Павлович является сформировавшимся специалистом высокой квалификации в области техники СВЧ, что подтверждается, в частности, избранием его в 2010 г. главным специалистом НИЯУ МИФИ, исполнением обязанностей начальника лаборатории № 104 ИСВЧПЭ РАН. Лисицким Антоном Павловичем, в частности, освоены и используются в работе САПР проектирования СВЧ монолитных микросхем Microwave office (США), ADS (США), международная система поиска патентной документации QPAT (QUESTEL), Франция.

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам.

Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

**Постановили:**

**По 1-му пункту повестки дня:**

1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности ведущего научного сотрудника лаборатории № 102 лаборатории исследования процессов электронной литографии формирования сверхкороткоканальных нм-транзисторов состоявшимся в объявленные сроки.

3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании бальной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалов, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- ведущего научного сотрудника лаборатории исследования процессов электронной литографии формирования сверхкороткоканальных нм-транзисторов

– Лисицкого Антона Павловича.

Председатель Конкурсной комиссии  
д.т.н., профессор  
Секретарь Конкурсной комиссии  
к.ф.-м.н.

«5» сентября 2019 г.



С.А. Гамкрелидзе

Р.А. Хабибуллин